

# InGaAs фотодиод 1654 нм, 200 мкм, ТО-корпус — техническое описание

P/N : WIMT-01AX

## ОСОБЕННОСТИ

- Высокая чувствительность
- Низкий темновой ток
- Спектральная чувствительность 900–1740 нм

## ПРИМЕНЕНИЕ

Датчики СН4

## ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Параметр                  | Обозначение      | Мин. | Макс. | Ед. изм.   |
|---------------------------|------------------|------|-------|------------|
| Рабочая температура       | T <sub>STG</sub> | °C   | -40   | 85         |
| Температура хранения      | T <sub>C</sub>   | °C   | -40   | 85         |
| Температура (время) пайки | T <sub>L</sub>   | °C   |       | 260 / 10 с |
| Прямой ток                | I <sub>CC</sub>  | мА   |       | 10         |

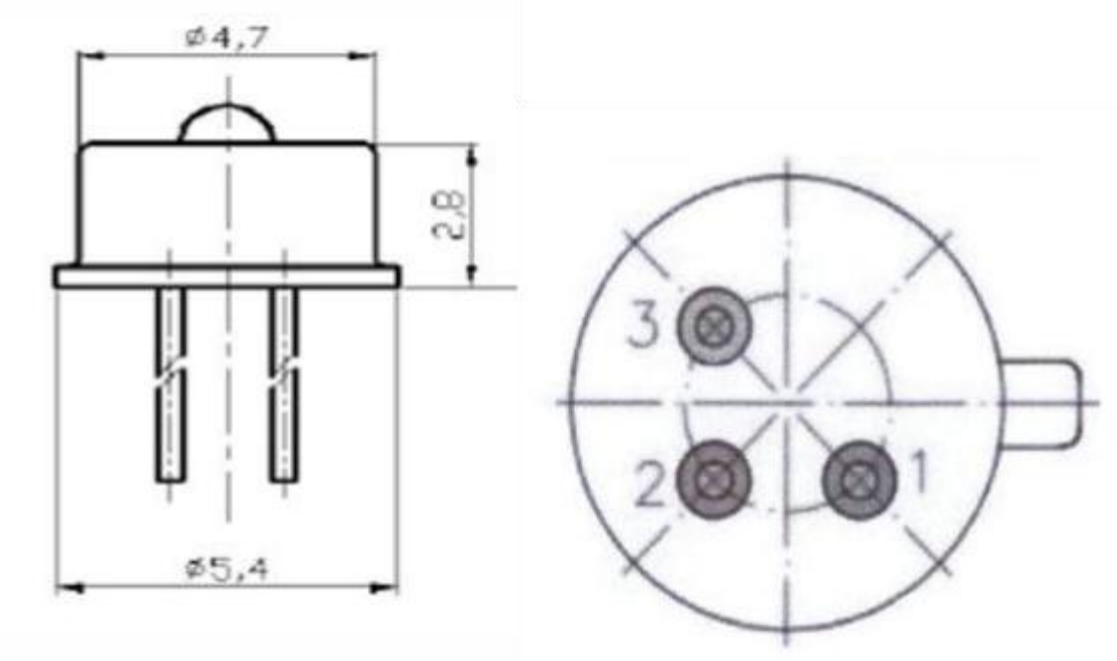
## Электрооптические характеристики (T=25 °C)

| Параметр                   | Обозначение | Условия измерения | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|----------------------------|-------------|-------------------|------|------|-------|----------|
| Активная область           | D           | -                 | 180  | 200  | 220   | мкм      |
| Темновой ток               | ID          | VBR=-10V          | -    | 0.3  | 1     | нА       |
| Рабочий диапазон длин волн | λ           | -                 | 900  | 1650 | 1740  | нм       |
| Чувствительность           | R           | λ=1653nm          | 0.9  | 0.95 |       | А/Вт     |
| Емкость                    | C           | VBR=-3V           |      | 3    | 5     | пФ       |

## ПРИМЕЧАНИЕ

При хранении, транспортировке и использовании рекомендуются соответствующие меры защиты от ЭСР.

Назначение выводов и габаритный чертёж



| № вывода | Название |
|----------|----------|
| 1        | PD+      |
| 2        | PD-      |
| 3        | GND      |